



瑞晶電子成功完成25nm 2Gb DDR3 DRAM試產

October 4, 2012

瑞晶電子(4932)為台灣專業DRAM製造商，以先進製程提供高品質、高效能之DRAM產品。4日，瑞晶電子宣布，已成功試產出使用爾必達(Elpida Memory, Inc.)所開發25nm製程的2Gb DDR3晶片，良率符合預期，未來將加速完成4Gb DDR3晶片試產，預計於2013年第一季全面導入量產。

新的4Gb

DDR3晶片產品，更加強化了高傳輸效能、低耗電的特性，生產成本上也更具競爭力。全新25nm製程技術，將使每片12吋晶圓產出晶粒量比30nm製程多出近4成；瑞晶電子總經理陳正坤指出：「此次試產結果，不論品質、良率均相當令人滿意，我們將加速進行25nm製程4Gb DDR3的試產，希望能在2013年第一季，全面導入量產。」

新的4Gb DDR3

DRAM傳輸率高達1866Mbps，但最低只需1.35伏特的電壓，在需要進行大量資料傳輸的個人電腦或伺服器上特別適用，亦可應用於筆記型電腦或平板電腦上。瑞晶電子未來也將持續專注於精進製程能力，持續提供市場高品質、高競爭力之DRAM產品。

聯絡人：郭佩珊(886-4-25218000 ext.8091)